OTR profile measurement of a LINAC electron beam with portable ultra high-speed camera

T. Mogi^{*}, S. Nisiyama, S. Tomioka, T. Enoto, Division of Quantum Energy, Graduate School of Engineering, Hokkaido University Kita-13jo Nisi-8chome Kita-ku Sapporo, Hokkaido, 060-8628, Japan

Abstract

We have studied on and developed a portable ultra high-speed camera, and so applied to measurement of a LINAC electron beam. We measured spatial OTR profiles of a LINAC electron beam using this camera with temporal resolution 80ns.

可搬型超高速度カメラを用いた LINAC電子ビームのOTR プロファイルの計測

1. はじめに

これまで本研究室では、プラズマ計測用の超高速 度カメラに関するさまざまな研究、開発を行なってき た。しかし、これらの超高速度カメラは数10ps~1ns の高時間分解能を目標としていたため大型であった。 一方で、若干の時間分解能が犠牲となっても、可搬 性を必要とする計測対象も少なくない。本研究では 可搬型超高速度カメラの開発を行い、この応用とし てLINAC電子ビームの高時間分解能計測を目指して いる。

高エネルギーの荷電粒子が、密度の異なる物質の 境界面を通過するときに、誘電率の違いにより可視 領域から X 線領域にわたった OTR(Optical Transition Radiation)が発生する^[1]。OTR は非常に速い応答を 示すため、その高時間分解能計測が行われてきた^[2]。 この OTR を超高速度カメラで撮影し、マクロパルス の時間的、空間的挙動を計測した。

2. 可搬型超高速度カメラ

可搬型超高速度カメラは ITT 製の近接型光増幅素 子 F4769 を用いた、無掃引型フレーミングカメラで ある。CCD カメラには Nikon 製のデジタルー眼レフ カメラ D100 を用い、その他レンズやベローズ等も 市販されている一般のカメラアクセサリを用いるこ とで可搬化を行った。シャッタリングおよび近接型光 増幅素子の動作電源は浜松ホトニクス製の高圧電源 C6083 を用いた。

現時点でのこの超高速カメラの時間分解能は80ns、 空間分解能は23 lp/mm であるが、今後装置全体の改 良も含め、時間分解能をサブナノ秒程度、空間分解 能を40 lp/mm 程度まで向上させる予定である。

3. OTR プロファイルの計測実験

今回 OTR の光源として厚さ 0.5mm の平滑なステンレス板を用いた。このステンレス板を、LINAC 電子ビームの進行方向に対して 45°傾けて設置した。そ

* E-mail: mog@athena.qe.eng.hokudai.ac.jp



の 90°方向に可搬型超高速度カメラを設置し、OTR を撮影した。その実験体系を図1に示した。

電子ビームは北大の 45MeV electron LINAC を使用 した。使用条件は加速エネルギー 45MeV、パルス幅 500ns、繰り返し周波数 10pps、ビーム電流 0.1µA、マ クロパルス一個あたりの電荷量は 10nC とした。

Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)





図 4: OTR の水平断面の発光強度分布 (10nC/bunch)



図 5: OTR の垂直断面の発光強度分布 (10nC/bunch)

超高速度カメラのシャッタリングのタイミングを図 2 に示した。今回シャッタリング時間は 80ns とした。 シャッタリングパルスの遅延回路でシャッタリングの タイミングを約 200ns 毎に変化させて撮影した。この とき、遅延を与えていない時刻は電子ビームがステ ンレス板に到達せず OTR が発生しない時刻とした。 このようにして、LINAC 電子ビームの各時刻におけ る OTR プロファイルを計測した。

4. 結果

図3に各時刻でのOTRの断面の発光強度分布を示した。ただし、各時刻での感度を同じとし、CCDカメラの飽和レベルで規格化した。図3においてOTRの中心付近では、発光強度がCCDカメラのダイナミックレンジを越えたため、輝度が飽和状態となった。図3より、今回の実験で使用した電子ビームは垂直方向に長い楕円の形状をしていることがわかった。

図 4 は図 3 の発光強度が飽和していない y = 8.4[mm] における水平断面の発光強度分布、同様に、 図 5 は図 3 の x = 15.1[mm] における垂直断面の発 光強度分布を示した。長軸方向 (垂直方向:y)の半値 幅は約 15mm、短軸方向 (水平方向:x)の半値幅は約 10mm であり、各時刻においてその半値幅が同等の結 果を示したことにより、発光強度分布が相似である ことがわかった。つまり、パルス幅 500ns での電子 ビームのマクロパルスは、パルスの立ち上がりと立 ち下がりにおいて、空間分布の断面形状が変化しな いことがわかった。

また、マクロパルス一個あたりの電荷量を変化さ





(a) 断面の発光強度分布 (400ns)



(b) 水平断面の発光強度分布



(c) 垂直断面の発光強度分布



せたときの、OTR の発光強度分布を図 6、図 7 に示した。図 3(c)、図 6(a)、図 7(a) により OTR のプロファ イルがほぼ同等ビームの形状であると示された。

5. おわりに

今回の実験で、LINAC電子ビームによる時間分解 能80ns でのOTR プロファイルの計測を行った。OTR の光量は十分大きいものであり、今後シャッタリング 時間を今回用いた近接型光増幅素子の限界値と思わ れる10nsまで短くした場合でも、光量は超高速度カ メラの必要感度を満たしていると見込まれる。

今後は、シャッタリングパルス10nsまで短くし、ス リットを用いたエミッタンスの測定、偏向電磁石を



(a) 断面の発光強度分布 (400ns)



(b) 水平断面の発光強度分布



(c) 垂直断面の発光強度分布

図 7: OTR の発光強度分布 (16nC/bunch)

用いたエネルギー分布の測定を行う予定である。さ らに、可搬性を損なうことなく大幅な装置の改良を 考慮にいれて、サブナノ秒程度まで時間分解能の向 上を目指している。

参考文献

- [1] L.Wartski et al., Jounal of Applied Physics, Vol.46, pp.3644-3653, 1975
- [2] T.SAKAI et al., Proceedings of the 20th Linear Accelerator Meeting in Japan, pp.239-241, 1995